

Сведения о ведущей организации

по диссертации Гончарова Олега Юрьевича

«Физико-химические основы низкотемпературного газофазного осаждения тугоплавких покрытий восстановлением галогенидов металлами»
на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 1.4.4. Физическая химия

Полное и сокращенное наименование организации	Почтовый адрес (индекс, город, улица, дом), телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»	Структурное подразделение	Основные работы работников ведущей организации по теме диссертации, опубликованные в рецензируемых научных журналах за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девярых Российской академии наук (ИХВВ РАН)	Адрес: 603951, Нижний Новгород, Бокс-75, ул. Тропинина, д.49 Телефон: +7 (831) 462-77-50 Факс: +7 (831) 462-57-64, +7 (831) 462-56-66 WWW: http://ichps.ru/ E-mail: bulanov@ihps-nnov.ru	Лаборатория веществ особой чистоты, лаборатория летучих соединений металлов	1. Гавва В.А. Получение монокристаллического изотопнообогатщенного германия-70 гидридным методом / В.А. Гавва, О.Ю. Трошин, С.А. Адамчик, А.Ю. Лашков, Н.В. Абросимов, А.М. Гибин, П.А. Отопкова, А.Ю. Созин, А.Д. Буланов // Неорганические материалы. – 2022. – Т.58, №3. – С.258–263. – DOI: 10.31857/S0002337X22030058. 2. Белозеров Ю.С. Кинетика фазового перехода $\alpha \rightarrow \gamma$ в железе различного изотопного состава / Ю.С. Белозеров, А.Д. Плехович, О.Ю. Трошин, А.Д. Буланов, А.М. Кутын, Ю.П. Кириллов // Неорганические материалы. – 2022. – Т.58, № 3. – С. 264-270. – DOI:10.1134/S0020168522030025 3. Shabarova L.V. Modeling of Thermogasdynamics and Thermal Processes of Volatile Halides of Elements of III, IV and VI Groups in Thermal Plasma of RF-IC Discharge at Atmospheric Pressure / L.V. Shabarova, R.A. Kornev, A.A. Ermakov, V.E. Shkrunin, A.I. Shishkin, A.A. Belov, P.S. Kalyasov // Plasma Chemistry and Plasma Processing. – 2022. – Т.42, V.6. – P. 1381-1403. – DOI: 10.1007/s11090-022-10276-w 4. Моисеев А.Н. Влияние условий осаждения из паров металлоорганических соединений на получение эпитаксиальных слоев n-CdTe с использованием изопропилиодида / А.Н. Моисеев, В.С. Евстигнеев, А.В. Чилисов, М.В. Костюнин // Физика и техника полупроводников. – 2022. – Т.56, вып. 3. – С. 350-356. – DOI: 10.21883/FTP.2022.03.52123.9767 5. Гибин А.М. Теплопроводность монокристаллов изотопно-обогатщенного германия ^{70}Ge, ^{72}Ge, ^{74}Ge в интервале 80–310K / А.М. Гибин, Н.В. Абросимов, А.Д. Буланов, В.А. Гавва // Физика твердого тела. – 2023. – Т.65, Вып.8. – С. 1448- 1452. – DOI:

			10.21883/FTT.2023.08.56167.65 6. Трошин О.Ю. Изотопно обогащенные кремний, германий и их гидриды для разработки квантовых устройств / О.Ю. Трошин, В.А. Гавва, А.Ю. Лашков., А.Ю. Созин, С.А. Адамчик, А.М. Потапов, П.А. Отопкова, А.Д. Буланов // Неорганические материалы. – 2023. – Т.59, № 11. – С.1-10. – DOI: 10.31857/S0002337X23110143 7. Kornev R. Plasma-Chemical Disposal of Silicon and Germanium Tetrachlorides Waste by Hydrogen Reduction / R. Kornev, I. Gornushkin, L. Shabarova, A. Kadomtseva, G. Mochalov, N. Rekunov, S. Romanov, V. Medov, D. Belousova, N. Maleev // Sci. –2024. –V6, 1(12). – DOI: 10.3390/sci6010001 8. Кутьин А.М. Развитие прикладного варианта теории кристаллизации Колмогорова-Джонсона-Мейла для обработки данных термического анализа. Термоанализ плавления изотопов германия / А.М. Кутьин, А.Д. Плехович, В.А. Гавва, А.Д. Буланов // Доклады академии наук. Химия и науки о материалах. – 2024. – Т.516, № 1. – С. 30-38. – DOI: 10.31857/S2686953524030046 9. Буланов А. Д. Особенности синтеза и свойства новых материалов на основе моноизотопных кремния и германия. Обзор / А.Д. Буланов, В.А. Гавва, О.Ю. Трошин // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2025. – Т.27, №1. – С.3–15. – DOI: 10.17308/kcmf.2025.27/12483 10. Евстигнеев В.С. Осаждение эпитаксиальных слоев CdTe на подложках GaAs с использованием диметилкадмия и метилаллилтеллура / В.С. Евстигнеев, А.В. Чилиясов, А.Н. Моисеев, М.В. Костюнин // Неорганические материалы. – 2025. – Т.61, № 11-12. – С. 683-691. – DOI:10.7868/S3034558825060017 11. Чилиясов А.В. Морфология поверхности, кристаллическое совершенство и электрофизические параметры гетероструктур CdHgTe/CdZnTe, выращенных МOCVD-методом / А.В. Чилиясов, А.Н. Моисеев, В.С. Евстигнеев, М.В. Костюнин, И.А. Денисов, А.А. Трофимов // Неорганические материалы. – 2025. – Т.61, №1–2. – С. 26–32. DOI: 10.31857/S0002337X25010039 12. Kornev R. Method for Removing Impurities by Treating Silicon Tetrachloride with Hydrogen Plasma / R. Kornev, G. Mochalov, N. Maleev, S. Romanov, K. Kornev, A. Kalinina // Inorganics. – 2025. – V.13, №3. – P. 80. – DOI: 10.3390/inorganics13030080 13. Буланов А.Д. Кинетика химической реакции горения тетрафторида кремния и дисперсного гидрида кальция в замкнутой системе при изотермических условиях / А.Д. Буланов, Ю.П. Кириллов, С.Ю. Кириллов, А.Ю. Лашков, О.Ю. Трошин // Неорганические
--	--	--	--

			материалы. – 2025. – Т.61, №3-4. – С.160–168. – DOI: 10.31857/S0002337X25030054 14. Kornev R. Application of ICP Plasma for Obtaining Chemically and Isotopically Pure Silicon / R. Kornev, A. Bulanov // Plasma Chemistry and Plasma Processing. – 2026. V.46 (4). – P. 67. –DOI: 10.1007/s11090-026-10671-7 15. Кошкин В.А. Получение изотопно обогащенного тетрахлорида германия $^{72}\text{GeCl}_4$ / В.А. Кошкин, А.Д. Буланов, О.Ю. Трошин, А.Ю. Лашков, А.Ю. Созин, А.А. Ермаков // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2026. – Т.28, №2. – С. 230–237. – DOI: 10.17308/kcmf.2026.28/13684
--	--	--	--

Директор ИХВВ РАН,
доктор химических наук,
член-корреспондент РАН

«19» июня 2026 г.



/ А.Д. Буланов /
расшифровка